	<h2 style="color: #E67E22;">NVMD6N03R2G</h2>
 	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NVMD6N03R2G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor</a> / <a href="#">ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 6A 8SOIC
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



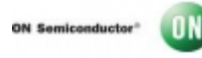


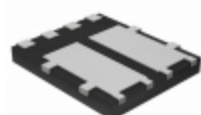
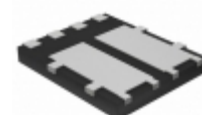
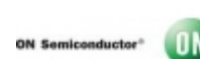
### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NVMD6N03R2G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor</a> / <a href="#">ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 6A 8SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SOIC
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	32 mOhm @ 6A, 10V
Leistung - max	1.29W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	950pF @ 24V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A

NVMD6N03R2G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVMD6N03R2G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVMD6N03R2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NVMD6N03R2G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NVMD6P02R2G</b> ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 4.8A 8-SOIC</p>	 <p><b>NVMD6N04R2G</b> ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 40V 4.6A 8-SOIC</p>	 <p><b>NVMD6N04</b> ON NVMD6N04 ON</p>	 <p><b>NVMD4N03R2G</b> ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 4A SO8FL</p>
 <p><b>NVMD3P03R2G</b> ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 30V 2.34A 8SOIC</p>	 <p><b>NVMFD5483NLT3G</b> ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 6.4A 8DFN</p>	 <p><b>NVMFD5483NLT1G</b> ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 6.4A 8DFN</p>	 <p><b>NVMD4N03</b> ON NVMD4N03 ON</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVMD6N03R2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVMD6N03R2G Datenblatt	NVMD6N03R2G-Datenblätter	NVMD6N03R2G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVMD6N03R2G
NVMD6N03R2G Electronic	NVMD6N03R2G-Komponenten	NVMD6N03R2G-Verteiler	NVMD6N03R2G-Bild	NVMD6N03R2G-Teil
NVMD6N03R2G Preis	NVMD6N03R2G Hersteller	NVMD6N03R2G Bild	NVMD6N03R2G Aktie	NVMD6N03R2G Inventar
NVMD6N03R2G Neu	NVMD6N03R2G Original	NVMD6N03R2G garantiert	NVMD6N03R2G RFQ	NVMD6N03R2G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited